Vol. 33, No.1 Feb. 2007

文章编号: 1671 - 0444(2007)01 - 0120 - 05

溅射沉积纳米 ZnO 膜的表征及其性能*

李良飞,侯大寅

磁超我能够重要运动的机000

摘 要:利用 RF磁控溅射法在 PET 非织造布表面沉积氧化锌(ZnO)薄膜,并利用原子力显微镜(AFM)和能量弥散 X-射线法(EDX)对 ZnO 薄膜的表面形貌和结构进行表征和分析.结果表明,沉积的 ZnO 颗粒具备纳米级尺度,且颗粒分布均匀、膜层致密,薄膜颗粒中只含有 Zn和 O 两种元素;随着沉积时间的延长,ZnO 呈多层生长模式.测试表明, 经 ZnO 镀层处理的 PET 非织造布具有较强的紫外线屏蔽效果和优良的抗静电效果.

关键词:纳米 ZnO;溅射;防紫外;抗静电;PET;非织造布 中图分类号:TN 16 **文献标志码**:A

Characterization and Capability of Nano-ZnO

Films Deposited by Sputtering

LI Liang-fei, HOU Da-yin

(Provincial Key Laboratory of Textile Fabric, Anhui University of Technology & Science, Wuhu Anhui 241000, China)

Abstract: ZnO thin films are deposited on PET nonwoven substrates by RF magnetron sputtering. The morphology and the structure of the sputter-deposited films are observed by Atom Force Microscopy (AFM) and energy-dispersive X-ray (EDX). The results show that, the deposited ZnO grains in nano-levels, the grains distribute equality and compact; the films only contain Zn and O elements; with extend the time of deposition, the growth mode of ZnO is multi layer growth. The tests indicate that the PET nonwoven which is deposited by ZnO thin films has high ability of absorbency ultraviolet and has antistatic excellently.

Key words: nano-ZnO; sputtering; ultraviolet resistance; antistatic; PET; nonwoven

纳米氧化锌(ZnO)由于颗粒的细微化,比表面 积急剧增加,使得纳米 ZnO 具备块状 ZnO 所不具 备的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应 等,在精细陶瓷、紫外线屏蔽、光电材料、高效催化 材料、纺织材料等方面具有广阔的应用开发 前景.[1] 近年来,通过等离子分子束外延法(P-MBE)[2]、激光分子束外延法(L-MBE)[3)等制得高 质量的 ZnO 薄膜,然而这些制备设备昂贵.磁控溅 射法利用磁场强大的能量轰击溅射靶材,在材料表 面沉积纳米薄膜,溅射法制备的纳米薄膜均匀、稳 定,不改变材料本身性能,是一种成膜速率较快、制

妝稿日期: 2006 - 08 - 21

基金项目: 安徽省自然科学基金项目(070414192)

作者简介: 李良飞(1980 -),男,安徽亳州人,硕士,研究方向为功能性纺织品的研究. E-mail: liliangfei9859 @yahoo.com.cn.侯大寅(联 系人),男,副教授,E-mail: houdayin0141 @sina.com

121

备工艺简单、成本低、能够大面积制备并且能够低 温结晶的方法.[4]目前磁控溅射方法多用于金属和 无机材料表面成膜研究,但是在纺织高分子材料上 溅射成膜的研究尚不多见.

原子力显微镜 AF M 是分析材料表面微观结 构重要手段之一,具有纳米级别的分辨能力、样品 表面不需要特殊处理等优点.[5] 纵向分辨率高达 0.01 nm,横向分辨率为0.1 nm.自从1968 年 FITZGERALD 等6 把X-射线能谱法 EDX)引用 到点子光学仪器以来,在物质的检测方面得到广泛 的应用,不仅对物质元素的组成进行表征,还可以 做到定量的分析.

1 实验材料与仪器

1.1 实验材料

本实验基材为江西国桥纺织有限公司生产的 60 g cm² PET 纺粘法非织造布,靶材为 99.99 % ZnO 陶瓷压片(50 mm ×4 mm).

1.2 实验仪器

沈阳聚智科技有限公司生产的 JZCK-420B 高真空多功能磁控溅射仪,配置直流和射频电 源;中科院本原纳米科技有限公司生产的 CSPM4000原子力显微镜(AFM),扫描模式为 接触模式;英国 Oxford 公司 Link ISIS - 300 X射 线能谱仪;美国铂金埃尔默公司的 LAMBDA 900 型紫外-可见分光光度计,波长精度 ±0.8 nm,波长 分辨率 1 nm; YG(B) 342D 型织物感应式静电测 定仪.

2 纳米 ZnO 溅射成膜

测载栈用のg/cm/的PET/挑去 誤告 布(2.3 cm x.3 cm). 实质的PET1 织合先经 过大酮曼包 KQ-50B型超声波青先,并用蒸馏 水反复青光、除去 PET1 织合于表面灰上和由 渍箸种子菜物、然后放入烘箱进入烘烧烘箱 圆落 在60 左右、烘燥5~10 min 后放入干燥 皿中得用

实际用RF磁弧射用Ar气为射气体, 气体症为20nL min 先初械家的子家時 空室体成玉壁5.0 ×0-4Pa, 靶本基本的路 为50nm 实绪承用Ar离子,把述为min利 溅以清晰表面分质

3 纳米 ZnO 膜的表征与分析

3.1 AFM 表征分析

在相同的溅射压强和功率情况下 (2.0 Pa, 180 W),对不同溅射时间(15,45,60 min)下制得的 ZnO 涂层 PET 无纺布薄膜进行 AFM 成像分析.图 1和 2 分别是不同溅射时间下制备的 ZnO 薄膜 AFM 的二维、三维图像.



图 1 不同溅射时间下制备的 ZnO 薄膜 AFM 二维图像 Fig. 1 The AFM planar pictures of ZnO thin films treated under different time





Fig. 2 The AFM three dimensional picture of ZnO thin films treated under different time

图 1 (a) 是 ZnO 的 AFM 二维图像;图2 (a) 是对 应的三维图像.从二维图像上我们看到在 PET 非 织造布表面分布着一些细密的颗粒,分布相对均 匀,而且颗粒粒径比较小,AFM 图形处理软件上反 映此时颗粒平均粒径是 30 nm,表面粗糙度为 30.4 nm.但是纳米 ZnO 颗粒还未能完全覆盖在 PET 纤维表面,这是因为在很短的时间内 Ar +轰击 ZnO 靶材的能量比较小,因此沉积到纤维表面的离 子和原子的密度比较小.从三维图像也能看出试样 表面比较平滑,没有明显的凸起颗粒,说明此时基 本上是单层生长的 ZnO 薄膜,而且薄膜是由纳米级 颗粒组成.

当溅射时间延长到 45 min 的时候,从图 2(b) 可以清楚地看到 PET 纤维表面已经被纳米 ZnO 完全覆盖,颗粒很细致、均匀,颗粒粒径为26 nm, 薄膜表面的粗糙度是 18.5 nm.这说明随着溅射时 间的延长,从 ZnO 靶材中溅射出的原子数目增多, 原子的生长速度加快,沉积到纤维表面的离子和 原子密度随之增加,颗粒粒径变得更加细小,得到 的纳米 ZnO 更加均匀,薄膜表面变得更加光滑.颗 粒形状类似六角状,颗粒之间明显有层次感,说明 此时薄膜的生长已经不是单层生长.从对应的三 维图像可以看到样品表面已经呈现出尖耸多层小 塔状,塔底与塔顶由无数的细小颗粒组成,更加直 观地说明此时 ZnO 生长模式是多层生长.

图 1 (c) 为溅射时间 60 min 下制备的 ZnO 薄膜 AFM 图像,图像基底覆盖良好,薄膜由大小不等的 颗粒组成,颗粒边缘圆滑,薄膜顶层的颗粒粒径大 于底层的颗粒,大颗粒由很多小颗粒组合而成,类 似多个小粒子的团聚.从图 2 (c) 中看到,整个薄膜 形状类似丘陵状生长,丘陵与丘陵之间的峡谷也由 密集的大小不等的颗粒组成,丘陵之间相连而构成 蜿蜒曲折的"山脉",这种薄膜的生长方式与传统的 成膜方式不同. [7.8]

3.2 EDX表征分析

利用 X - 射线能谱仪 (EDX) 对制备前后的 PET 非织造布表面元素成分进行分析. 图 3 结果显示,在 PET 非织造布表面只检测到 C 和 O 两种元素. 图 4 是经过镀层整理以后 ZnO 薄膜表面所含有元素的 EDX 图像. 结果显示,在制备的 ZnO 薄膜表面只含有 Zn 和 O 两种元素,没有检测到其他元素的存在,而且 Zn 和 O 两种元素的质量分数分别为 78.19 %和 21.81 %,说明利用 RF 磁控溅射制备的纳米 ZnO 薄膜的纯度非常高.



图 3 PET 非织造布原样表面元素的 ED X 图像 Fig. 3 ED X picture of surface element of PET non woven



第1期

图 4 ZnO 薄膜表面元素的 EDX图像 Fig. 4 EDX picture of surface element of ZnO thin films

4 纳米 ZnO 薄膜的性能分析

4.1 纳米 ZnO 膜的防紫外线性能分析

利用 LAMBDA 900 型紫外 - 可见分光光度计 对 PET 非织造布表面镀膜前后紫外线通透性能进 行测试.测试样品大小为 5.8 cm ×2.8 cm.图 5 中 曲线 1,2,3 和 4 分别是未处理以及处理 15,45 和 60 min的紫外线透过率曲线.



图 5 PET 非织造布表面镀膜前后防紫外性能 Fig. 5 The capability of prevent ultraviolet radiation of plating films of PET non woven

分析比较后发现,在波长 300 nm 左右紫外区 域,镀层前后 PET 非织造布的紫外光透过率相差 不大,在 300~400 nm 紫外区域,经 ZnO 镀层处理 的非织造布对紫外光吸收能力明显比未处理非织 造布增强.而且从图中可以看到,随着溅射时间的 延长,纳米 ZnO 膜屏蔽越好.纳米 ZnO 对紫外光的 吸收主要源于两个原因:首先利用纳米 ZnO 颗粒 的量子尺寸效应,使其对紫外光的吸收带产生"蓝 移现象"和"宽化现象"导致其对紫外光吸收显著增 强.[9]其次由于它的半导体性质,即在紫外光照射下, 电子被激发由价带向导带跃迁,ZnO 禁带宽度为 3.0 eV,根据 *E*= *h* × (*E*:光量子能量;*h*:普朗克常 数;:光量子频率),计算它所需要的激发光最大的 波长为410.3 nm,因此,波长小于410.3 nm的光都可 以被纳米 ZnO 吸收,从而在紫外区形成宽的吸光 带.此外,ZnO 的折光率非常小,仅为 1.9,因此对光 线的漫散射率低,透明度高,具有良好的可见光透 过率.在 400~600 nm 可见光区域两者的透过率都 在 60%左右,说明 ZnO 薄膜具备良好的可见光透 过性.

5 纳米 ZnO 薄膜的抗静电性能

表 1 ZnO 镀层处理前后非织造布抗静电效果 Table 1 The antistatic effect of nonwoven

coating treated with ZnO

样品	峰值电压 N	半衰期/s
镀层处理前	8	13.00
镀层处理 15 min	7	0.02
镀层处理 45 min	6	0.01
镀层处理 60 min	7	0.01

注:环境条件为温度 25 ,相对湿度 40 %.

由表 1 可知,与 PET 非织造布相比,经过 ZnO 镀层处理后的 PET 非织造布的抗静电性能明显改 善.这是由纳米 ZnO 本身结构造成的.由于 ZnO 的 六角密堆纤锌矿极性结构,常温下本征缺陷的存 在,填隙 Zn 离子的电离,使它具有 N 型电子导电, 其晶粒电阻非常小,在室温下或更低的温度下就能 导电.当给样品施加高压的时候,ZnO 不但能阻止 静电荷的产生,同时能对其进行快速溢散,达到非 常优异的抗静电效果.从表 1 中也可以看到,经 ZnO 镀层处理短时间内半衰期就达到 0.02 s,而且 随着沉积时间的延长半衰期数值基本没有变化,可 见经过 ZnO 镀层处理之后短时间就具备了良好的 抗静电效果.

123

6 结论

124

(1)测射带的石O颗矿散约,薄敷) 致密生好,纯度高薄敷生长元均移动膜 元、石有较为和容易数件发射

② 经ZAO测力据录理的PET非织造行对 影/光区或有因的吸收能力,随着不用时间延 长、薄膜的影/线开蔽/果越子可见光区或表现 为较高的透空率,说明你长ZAO薄膜有良子的透 光性

③经ZAO镀灵理卫MFPET非织命 仿静扩散来沉积时的校园情电开数 果研究景响

文 献

 XUJ Q, PAN Q Y, SHUN YA, et al. Grain Size Control and Gas Sensing Properties of ZrO Gas Sensor[J]. Sensors and Actuators B: Chemistry, 2000, 66(1 - 3): 277 - 279.

- [2] CHEN Y F, BAGNALL D M, ZHU Z Q, et al. ZnO Quantum Dotsa Novel Materal for the Fabrication of Semiconductor Lasers[J]. Apple Phys 1998,84: 3912.
- [3] KIM H, PIQUE A, HORWITZ J S, et al. Effect of Aluminum Doping on Zinc Oxide Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition for Ornanic Linht-emitting Devices
 [J]. Thin Solid Films, 2000: 377 - 378.
- [4] KIM KJ, KIM J H, KANGJ H. Structural and Optical Characterization of Cu₃N Films Prepared by Reactive RF Magnetron Sputtering [J]. J Cryst Growth, 2001, 222: 767.
- [5] BINNIN G, QUATE C F, CERBER Ch. Atomic Force Microscope[J]. Phys Rev, 1986, 56(9): 930-933.
- [6] FITZCERALD, RAY, KEL, et al. Solid-state Energy-Dispersion Spectrometer for Electron-microprobe X-ray Analysis[J]. Science, 1968, 159: 528-530.
- [7] 薛齡,吴全德,李洁薄燉加理[M].北京:电子工业出版 社,1991:21-22.
- [8] 田氏波,刘德令. 薄膜 半与技术手册(上册)[M]. 北京: 机 械工业出版社,1991: 22.
- [9] 李 昕. 纺织品的防紫外缘副整理[J]. 天津於珠壮, 2004, 42(3): 14-20.

(上接第 119 页)

当喷丝板 *i*+*j*的网格区间在光学镜头正下,由 于微孔的几何形状一部分在 *i*+*j* 网格内,有光线直 射到光学镜头上,通过"在 *i* 网格内"讨论的纠偏原 理进行自动纠偏,此时需纠偏2次才能使微孔几何 形状成像在光学镜头正中间,第1次纠偏使微孔几 何形状完整地成像在光学镜头孤场范围内,第2次 纠偏使微孔几何形状成像在光学镜头正中间.

3 结论

这里是出一种基于机器观觉的后部搜索算法;这开至图象采集卡,这对第1卡,步进机及 惩据,X,Y,W移开台,液来处于LED光原, CCD(琼器、光学家)、图象近野等,各门等机。 并实验书取导动,其4偏绐高,实现专为 偏能解决了目前递级专为创义不能剑 一些递级上名在道篇书的制,提高了递 板手检测的手が程度不如此,读4偏原 理15月,对其他一些基于形器观觉。检测,实现 其主称4偏扩能,同样有一定的启发出价值和 参笔义

参考文献

- [1] 王 越 喷丝板的发展现状[J]. 纺织机械,2001,(6): 45-46.
- [2] FZ/T92043-1995,中华人民共和国济济训标值[S].
- [3] 田天有.图象包括应用技术[M].北京:电子工业出版社, 2003: 285-300.